## \*\* Dialog

# ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE HAVING INPROVED POWER CONVERSION EFFICIENCY

Publication Number: 59-194393 (JP 59194393 A), November 05, 1984

#### **Inventors:**

- SUCHIBUN AARANDO BANSURIKU
- CHIYAN UON TAN

### **Applicants**

• EASTMAN KODAK CO (A Non-Japanese Company or Corporation), US (United States of America)

Application Number: 59-058088 (JP 8458088), March 26, 1984

## **Priority:**

6-478,938 [US 478938-1983], US (United States of America), March 25, 1983

## **International Class (IPC Edition 3):**

- H05B-033/14
- C09K-011/06

#### **JAPIO Class:**

- 43.4 (ELECTRIC POWER--- Applications)
- 13.9 (INORGANIC CHEMISTRY--- Other)

## **JAPIO Keywords:**

• R007 (ULTRASONIC WAVES)

## **JAPIO**

© 2003 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 1482793

			-

## 19 日本国特許庁 (JP)

## ①特許出願公開

## <sup>®</sup>公開特許公報 (A)

昭59-194393

⑤Int. Cl.³H 05 B 33/14// C 09 K 11/06

識別記号

庁内整理番号 7254—3K 7215—4H ❸公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 12 頁)

砂改良された電力転換効率をもつ有機エレクト

ロルミネツセント装置

②特

願 昭59-58088

❷出

願 昭59(1984)3月26日

優先権主張

②1983年3月25日③米国(US)

**3)478938** 

⑫発 明 者

スチープン・アーランド・パン スリク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ ント・ストリート324

**⑫発 明 者 チャン・ウオン・タン** 

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14626ロチエスター市パーモン ト・ドライブ197

②出 願 人 イーストマン・コダツク・カン

パニー アメリカ合衆国ニューヨーク州

14650ロチェスター市ステート

ストリート343

⑭代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

明細 管

1. [発明の名称]

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミネツセント装置

2.[ 特許請求の範囲]

順次陽極、正孔インジェクション帯域、有機 発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは1μm を越えない)、および陰極からなり、

これらの電極のりち少なくとも一方は 400 nm 以上の放長をもつ輻射線の少なくとも 80 まを 透過させることができ、かつ

少なくとも 9 × 1 0<sup>-8</sup> W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネンセント接着。

3. [発明の詳細な説明]

本発明は、有機化合物を発光手段とする、 軽 気信号に応答して発光するエレクトロルミネッ セント接触に幅する。

有機エレクトロルミネッセント 装置がそれらの対抗品と十分に対抗しりるものとなるためには、対抗しりるコストにおいてそれらの電力転

図動館圧を25ポルト以下に低下させるためには海膜型エレクトロルミネッセント接置が望ましい。これはここでは有効な帯域または増の厚さ、すなわち電極間にある物質の厚さが1μmを聴えない接触を意味する。ピンホールの問題を考えると海膜の形態を達成することは特に困難であった。ピンホールは電池をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー・ RCAレビュー、Vol. 30、322ff 頁 · - (1969年6月)、特に326頁を参照され たい。ピンホールの形成を防止するために、被 獲用配合物中に結合剤を使用することが好都合 とされている。この種の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリスチレン。および縮合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。単他のショ - トは避けられるが、結合剤を使用することは 不満足な場合がある。とのためには溶剤被獲加 工法を用いる必要があり、ある瘠の格剤は下層 の溶剤としても作用する可能性があり、これに より確闘の明瞭な境界設定が妨げられる。結合 剤を必要とする1層を溶剤被獲したのち結合剤 を必要としない瞳(1層または多層)を蒸篭さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光層を溶剤被覆する場合、密剤が下階に影響を 与えた場合の実用性は証明されていない。

米国有許明 4.3 5 6.4 2 9 号明細事に記載された鼠池は、正孔インジエクション帝城

わせた厚さは1 μm を越えない)、および陰復 からなり。 .

これらの電優のうち少なくとも一方は400 nm 以上の波長をもつ輻射線の少なくとも80 まを 汚過させることができ、かつ

少なくとも 9×10 W/W の電力転換効率をも つエレクトロルミネッセント装置が提供される。

好ましくはこの接触の発光帯域は、i 12 5 ポルト以下かよびii) この接触の最大配力転換効率を与える選圧以下で駆動される試験選性に用いた場合。少なくとも 5 × 10 \* 光子/鑑子のエレクトロルミネッセント 量子効素を置け1 1 エレクトロルミネッセント 量子放験装置は1) エニル)シクロヘキサンからなる正孔インション帯域(この正孔インジェクション帯域を合わせた 噂さは1 4m を超えない)、2) 400 nm 以上の波長をもの少なくとも80 %を透過させる陽板、かよ

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる層をもつ本発明のものと同じ型の装備の一例である。

上記特許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望まれている電力転換効率、
すなわち25ポルトを越えない駆動戦圧を用いた場合に少なくとも9×10°W/Wの水準を達成していない。正孔インジェクション層内のポルフイリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという望ましくない傾向を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔および電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも1桁改良された、 すなわち少なくとも9×10°W/W に及ぶ電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下°EL") 装備を提供することである。

本発明によれば、順次陽極、正孔インジエク ション帯域、有機発光帯域(これらの帯域を合

びる) インジウム製陰極から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力 転換効率を示す。

本発明の装置において発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これは本発明の実施聴様の多くにおいてそれぞれの 帯域に結合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔インジェクション府用として、発せられた輻射線に対し実質的に透過性である化合物が見出された ことである。

本発明の他の有利な特色は感付の図面を考慮 に入れて後記の好ましい実施態様を診照することにより明らかになるであろう。 第1図は電源 に接続した本発明接臘の一部の概略的断面図で あり、

第2図は本発明に従って製造された毎値に関する 載力転換効率対エレクトロルミネツセント 量子効率を示す対数一対数グラフである。

正孔インジェクション 物質および発光物質は 各帯域内に存在する( この帯域が層であっても 他のものであっても)。 好ましいエレクトロル ミオンセント 毎瞳においてこれらの物質は順次 重なった被膜ないしは鱶中に存在する。

正化インジェクション脳は正孔伝達化合物か ちなり、一方発光層は 畦子伝達化合物からなる。

本発明の装置に用いられる電子伝導化合物は、 酸化環元反応において還元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子転換効率または25ポルトのいずれかに選するまで(いずれが先に起 こるとしても)高める。この電圧において最大 EL量子効率を測定する。

表 | には、上記のように構成され、かつ上記の遺圧で駆動される装庫において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するE L 量子効率を示す。これらの例のそれぞれにつき、最大E L 電子効率の遺圧は25 ポルトの制限以下であった。

る。本発明において質に有用なものは、前記の 試験に関して少なくとも 5×10<sup>4</sup> E L 妻子効塞 を与える電子伝達化合物である。周知のように E L 妻子効率は単純に外部回路で測定される電 子/秒に対する、セルから放出される光子/秒 の比に等しい。この効率を成力伝換効率(W/W の単位で定義される)と混同してはならない。

電子伝達化合物が少なくとも 5×10 光子/ 電子( すなわち 0.05%) のE L 観子効率を与えるか否かを判定するためには下配の試験を行う。

ELセルは下記の順序で構成される:
400nm以上の放長をもつ輻射線の少なくとも80%を活過させる陽優[たとえばオザトロン(Nesatron、商標)ガラス];本質的に
1,1-ビス(4-ジーpートリルアミノフェニル)シクロヘキサンからなる正孔インジエクション階;問題の電子伝達化合物の階;およびインジウム製陰優。とこで正孔インジェクション階と発光層は合わせて噂さ1μを越えない。駆

ですできまり	BE 1000000000000000000000000000000000000	1.8 <			2 0 V		2 0 V		15 V		125V	27.	2 4 V		1 5 V		1 4 V		
 	瓦工量子効率	2×10		÷	1×10	e i	8×10		3×10		3×10.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15×10	•	5×10	, •	8×10		-
- 1	妈	<b>ネガトロン路領/オピンドリシャン</b>	(1500Å)/インジケム(In 1陰循	( 75 )	<b>メデトロン郵係/HI−1 (75nm)/E1</b>	(75nm)/In勒衛	*サトロン郵橋/HI−1(75nm)/E2	(75mm)/In函能	<b>オサトロン配像/HI‐1(75nm)/E3</b>	(75nm)/In解除	アジーチェング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チン・コンを通く11.1~~~~~11.1~ガル~~~1.4。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	************************************	(75nm)/In路衛	ネザトロン場権/HI-1(75nm)/E7	(75nm)/In磁艦	

E5を除って有効数子 1 個に四格五入した。

1エピドリジン=

2 H I - 1 = 1,1 - ピス(4 - ジーp - トリルブミノフェニル)シクロヘキサン

[4,4'-ピス[5,7 - ジャーペンチルー2 - ペンゾキサゾリル]スチルペン]

4 E 2 =

[2,5-ビス[5,7-ジ-t-ペンチル-2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

[2,2'-(1,4-フェレンジピニレン)ピスペングデアソール]

6 E4=

[2,2'-(4,4'-ピフェニレン)ピスペングチアゾール]

7 E5= ビス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

[2,5-ビス[5-(α,α-ジメチルペンジル)-2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

[ 2,5 - ピス[ 5,7 - ジ- t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル ] - 3,4 - ジフェニルチオフエン ]

ことで用いられる正孔インジェクション層の 正化伝達化合物は、電場を与えられた 2 個の電 極間に配職されて陽極から正凡がインジェクト された場合、正凡を適切に陰極へ伝達すること ができる化合物である。好ましい正孔伝達化合 物は、10<sup>4</sup>~10°ボルト/皿の電場を与えられ た 超極間に層が配置された場合少なくとも10° ペーパルトー秒の正凡移動係数をもつ。最も好 ましい正孔伝達化合物は容易にかつ可逆的に酸 化されりる芳香族アミンであることが見出され た。

より好ましくは、正化インジェクション層は本質的に無色である。これは陽極に隣接した位離にあり、陽極は透明な電極であることが好ましい。従って正化伝達化合物も400nm 以上の波長において少なくとも90%透過性であることが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物 の好ましい例には、室温で固体であり、かつ少なくとも1個の観察原子が懺換基でトリ懺換さ

あるいは他の場合には正化と電子の発光的再 結合を妨げない結合剤も本発明に有用である。

前記のように薄膜を形成しらる化合物の有用な例を以下に示す。 例に有用な例には複素環もしくは炭素環、 かよび 3 個以上の炭素原子を有する脂肪族鎖少なくとも 2 個を含有するか、 あるいは少なくとも 2 個の基すなわちそれぞれ。) 一重結合の出りに回転してる基かよび。) 少なくとも 3 個の芳香族もしくは飽和炭素濃を含む 花を含有する化合物が含まれる。

たとえば薄膜形成性である正孔伝達化合物に は次式の構造をもつものが含まれる。

れた(そのうち少なくとも1個はアリール基または置換アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な置換基の例には、1~5個の炭素原子をもつアルキル基、プチル基やよびアミル基、プロピル基、プチル基やよびアミル基;ハロゲン原子、たとえば塩器原子をよびフン累原子;ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基、ブーボキン基、ブテル基かよびアミル基である。

本発明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、かよび電子伝達化合物のあるものは、薄膜形成性化合物であるという付加的な性質をつとが注目される。ここで用いられるようにのる化合物がこの物質を配板などの支持体上に 0.5 μm 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 である場合、これは 実質的に ビンホールを含まない情を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であるということは必ずしも 0.5 μm よりも多數に存在しないということを意味する

1,1-ピス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン;および次式の構造をもつ 化合物

(上記式中nは2~4の整数である)。たとえば4.4%-ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

ェニル。

さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国特 許年4.175,960号明細書13欄13行から 14欄42行に列挙されたもの。たとえばビス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) フェニルメタンかよびN.N.N-トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

薄膜形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には螢光増白剤が含まれる。最も好ましいものは次式の構造をもつ螢光増白剤である。

R<sup>3</sup>は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族 残悪、たとえばメチル基、エチル基およびn-アイコシル基:6~10個の炭素原子を有する アリール基、たとえばフェニル基およびナフチ ル基:カルポキシル基:水業原子;シアノ基; あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原子およ びフン素原子であり;ただし式c) において R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup> および R<sup>3</sup>のうち少なくとも2個は3~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、たとえばプロピル基、プチル基またはペプチル基であり、

Zは - O - . - NH - または - S - であり; Yは - R $^{\circ}$ +CH=CH+ $^{\circ}$ R $^{\circ}$  - .

mは0~4の整数であり;

nは0,1,2または3であり;

R° は6~10個の炭素原子を有するTリーレン基、たとえばフェニレン基およびナフチレン基であり;

 $R^7$  は水器原子または  $6\sim 10$  個の炭素原子を有するアリール基であり、そしてZ' およびZ' は別個にNまたはCH である。

上記の脂肪族残磋は憧険されていてもよい。置

換された脂肪族残善の場合の置換基には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基およびプロピル基:6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基およびナフチル基;ハロゲン原子、たとえば塩素原子およびフン素原子;ニトロ基:ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン基、たとえばメトキシ基、エトキシ基およびプロポキシ基が含まれる。

特に好ましい盤光均白剤の例には下記のものが含まれる。2,5 - ピス(5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) - 1,3,4 - チアジアゾ - ル;4,4' - ピス(5,7 - t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) スチルペン;2,5 - ピス(5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) チオフェン;2,2' - (p - フェニレンジピニレン) - ピスペンゾチアゾ - ル;4,4' - ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル;2,5 - ピス[5 - (α。σ - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン;4,4'-

ビス[5,7 - ジ- (2 - メチル - 2 - ブチル)
- 2 - ベンゾキサゾリル]スチルベン: および
2,5 - ビス[5,7 - ジ- (2 - メチル - 2 - ブ
チル) - 2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフェニルチオフェン。

さらに他の有用な後光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637 頁かよび640 頁に列挙されている。すでに薄膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって薄膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な螢光増白剤には、たとえば下配のものが含まれる。

[2-{2-[4-(2-ベンゾイミダゾリル) フェニル ]ビニル ] ベンゾイミダゾール ]

(5-メチル-2-(·2-(4-(5-メチル-2-ベンゾキサゾリル)フェニル ] ビニル }ベンゾキサゾ-ル ]

[ 2,5 - ヒス ( 5 - メチル - 2 - ペンゾギサゾ リル)チオフェン]

[2-[2-(4-カルボキシフェニル)ピニル]ペンソイミダソール] および

[ 2 - [ 2 - ( 4 - クロルフェニル)ビニル] ナフト[ 1,2 - d ]オキサゾール]

さらに他の有用な博膜形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロギシギノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は好ましくは2n.Al.Mg またはLi である。

有効層の一方が薄膜形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため装置がショートすることはないので、他方は薄膜形成性である必要はない。たとえば有用な装置は、前記の薄膜形成性化合物からなる正孔インジェクション圏、および博膜形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4ーテトラフェニルー1,5ープタジェンからなる発光瘤を含む。

前記の装しから明らかなように、有用な陽便 電極には簡牒"ネザトロン"のもとにPPG1

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽振 が含まれ、有用な陽振塩極にはインジウムが含 まれる。一般のいかなる勝億および陰極もそれ が適切な仕事機数値をもつならは便用できる。 たとえば勝徳は高い仕事蝌故をもつべきである。 他の有用な陽便の例にはいずれかの半透明な高 い仕事関数をもつ導電性材料、たとえば酸化ス ズインジウム、鍛化スズ、ニッケルまたは金で 被獲したガラスが含まれる。好ましくは、この 種の陽極は10~1000ォーム/スクエアー (ohms/square)のシート抵抗、および400 nm 以上の放長に対し30%の光透過率をもつ。 このように高い光透過器を少なくとも90まと いう正孔伝達化合物の透過率と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である卓 越した低力伝換効率が保証される。

他の有用な陰極の例には低い仕事関数をもつ 他の金属、たとえば銀、スズ、鉛、マクネンウム、マンガンおよびアルミニウムが含まれる。 金属が毎體により発生するルミネツセンスに対 して高い透過率をもつか否かは関係ない。

明1図は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント装置を示す。これは酸化スズインジウムの半透明被膜16で被覆されたガラス製支持体14からなる陽極12を含む。この上に正孔インジェクション層18が配置される。溶光層20は層18上に配置される。溶18かよび20の一方または双方が薄膜形成性化合物である。陰極22は層20上に配置され、リードワイヤ24が接近を電源26に接続する。電源26を入れると陽極12で発生した正孔は層18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hレを発する。

電源26が装置10の最大出力点の選圧たと えば15~25ポルトで操作される場合、最大 電力転換効率は少なくとも9×10°W/Wであ る。ある場合にはこの効率が2×10°に及ぶこ とが認められた。本発明の装置は改良された電 力転換効率の結果1700cd/㎡(500フィー

トランペルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 認められた。

本発明のEL接徹は常法により作成される。 すなわち正孔インジェクション層、発光層および陰極をそれぞれ軽被被にまたは蒸発により 施す。正孔インジェクション層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用な溶液の れることが好ましい。発光層に有用な溶液の れんとながないい。発光層に有用な溶液の れんとながない。 発光層を形成するためには蒸発が好ましい。 ましい。ここで用いられる"蒸発"には蒸気を するのな着のあらゆる形態が含まれ、真空下で われるものも含まれる。

下記の実施例により本発明をさらに説明する。 これらの実施例において最大輝度は不可逆的破 機を生じる選圧のすぐ下の選圧で測定される。 若干の実施例において駆動選圧について25 V という好ましい限度を越える輝度に関する選圧 が示されているのはこのためである。

#### 夹施例1

**勇 1 図のものと類似したエレクトロルミネッ** 

セント袋屋(以下"セル")を以下により製造 した。

1) 陽標を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.05 μm アルミナの研摩材で数分間研取した、次いでイソプロピルアルコールおよび 蒸か 水の1:1 (M混合物中で超音波清浄した。 次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、窒素で送風乾燥させた。 最後に、 使用前にこれをトルエン中で超音波清浄し、 設案で送風乾燥させた。

2) 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸落法により沈滞させた。すをわち上配物質を選気的に加熱されたタンタル製ポートから320℃の温度で5×10<sup>5</sup>トルの采内圧力において蒸発させた。ネザトロンガラスに沈潜した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。

3) 次いで4,4'-ビス(5,7-ジ-t-ベンチル-2-ベンゾキサゾリル)スチルベン(E1)

を 2 i に配載したと同じ手法を用いて、ただし 供給源温度 3 5 0 ℃を採用してH I - 1 増の上 部に沈霜させた。E1層の厚さも 7 5 nm であ

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部に シャドーマスクを介して沈滑させた。In 戦傷 の面積は D.1 cmであり、これもエレクトロルミ オンセントセルの有効面積を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電額をプラスとしてパイアスをかけた場合、育緑色の光を放出した。放出された光は520 nm に最大放出を有していた。違成された最大輝度は与えられた電圧が22Vである場合。電航密度140mA/cmにおいて340cd/m であった。20Vで駆動した場合。最大電力転換効率は1.4×10<sup>3</sup>W/W であり、最大エレクトロルミネッセント数子効率は1.2×10<sup>2</sup>光子/電子であった。

#### 実施例2

檸膜形成性でない正化インジエクション層の

2 D ポルトで駆動した場合、最大電力転換効器 は 8.1 × 1 0 W/W であり、最大E L 電子効 密は 6.9 × 10 光子/ 電子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジエクション層は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを証 明している。

#### 実施例る

#### 発光暗用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし下記の繁光増白剤を発光値として明いた。

〔 2,5 - ビス( 5,7 - ジ - t - ベンチル - 2 -ベンゾヰサゾリル) - 1,3,4 - チアジアゾ - ル〕

#### 使用

実施例1に記載したようにエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしN.N.Nートリ(p-トリル)アミンを正孔インジェクション階としてHI-1の代わりに使用した。このアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に配散したものと同じ方法で製造された。ただしアミン蒸発のための供給源温度は120℃であった。厚さは75 nm であった。このセルに30 Vをかけた場合、電流密度40 mA/cd および最大輝度102 cd/m が得られた。放出された光はこの場合も背緑色であり、520 nm に最大放出を有していた。

実施例1と同様にしてセルを製造した。ただし蟹光増白剤の蒸発のための供給源温度は260でであった。放出された光は橙色であり、590nm に般大放出を有していた。得られた最大輝度は30 V かよび40 mA/cdにかいて340cd/㎡であった。20 V で駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10 W/W であり、最大正し貴子効率は1.4×10 光子/量子であった。

### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンシビニレン)ビスペンゾチアゾール(E3)を発光層として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル (オザトロン/HI-1/E3/In)

は緑色の光を放出し、これは560nm に最大 放出を有していた。得られた最大輝度は17.5 V および 200 mA/cmにおいて 340 cd/m で あった。 15 V で駆動した場合、般大電力転換 効率は4×10 W/W であり、最大エレクトロ ルミネッセント量子効率は 3×10° 光子/量子 であった。

#### 突旋例5

#### 発光催用の他の物質

前記実施例1と同様にしてエレクトロルミオ ツセントセルを製造した。ただし2-(4-ビ フェニル) - 6 - フェニルペンゾキサゾール (PBBO)を発光僧としてE1の代わりに用 い、200℃で蒸発させた。

このセル(オザトロン/HI-1/PBBO/In) は白青色の光を放出した。得られた最大輝度は 25 V および 50 m A / cml において 34 c d / mlで あった。20Vで駆動した場合、最大電力転換 効率は9.5×10 W/W であり、後大エレクト ロルミネッセント量子効率は8×10 光子/電 子であった。

#### **契施るおよび7**

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセ ントセルを製造した。ただし発光管はE1の代 わりに 2,5 - ヒス〔5 - ( α . α - ジメチルベ ンジルリー2 - ベンゾキサゾリル〕チオフエン ( 実施例 6 ) および 2,5 - ピス [ 5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリルJ - 34 - ・ ジフェニルチオフェンからなり、340℃の温 度で蒸発させた。表』に結果を示す。

	8 8 8 8 8 6 7 6 7	15V	1 4 V
#¥	藤 形 子 珍 子 珍 ひ ひ ひ	5×10 <sup>3</sup> 電子/概子	1.4×10 84×10 W/W 表子/電子
	機関線大体の数を変える。	7×10* W/W	1.4×10 w/w
	長樓大医	680cd/m' (19V5LG 150mA/cd	1700cd/m' (20Vかび 300mA/cd において)
	表放大出	530 nm	•
	<b>4</b> D	₩.	•
	果商司	•	~

#### 奥施例8

#### 薄膜形成性でない電子伝達化合物

奥施例1と同様にしてエレクトロルミオッセ ントセルを製造した。ただし、1,1,4,4-テト ラフェニル~1,3ープタジエン(TPB)を発 光層として用いた。

TPB昇華のための供給源温度は210℃であ った。このセルは青色の光を放出し、これは 450 nm に最大放出を有していた。得られた 母母は20Vおよび200mA/cm において 102cd/㎡ であった。15 Vで駆動した場合、 最大電力伝换効率は2×10 W/W であり、最 大エレクトロルミオッセント量子効率は1.2×10 光子/量子であった。とのセルは蒸発したTPB

層の不均領なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB膚は顕微鏡下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外観を有していた。

奥施例タンよび10

電子伝達化合物として8-ヒドロキシキノリグ の金銭錯体を使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしピス( 8 - ヒドロキシキノリノ)アルミニウム(実施例9)、および次式

操作条件は実施例1の記載と同様であった。ただし金属錯体の供給源温度はそれぞれ330℃(実施例9)かよび410℃(実施例10)であった。 表 ▮ に結果を示す。

の構造をもつピス(8-ヒドロキシキノリノ)

マグネシウムをそれぞれ発光階として用いた。

	跟 <b>第</b>	r.	2 4.
	<b>感日子</b> 大 1 年 本	5.8×10³	1.5×10³ **7.4°F
	表 大 機 力 (M/W)	8.2×10	1.4×10
嵌	表源 大策(元/p。)	340 (15V±£0; 50mA/al	340 (24V&LO 100mA/cd (C&VT)
	数田故田なれるかれるの故のとなる。	数 515nm	548nm
	政な光田北の田大色	蘂	葉
	路	٥	10

上配各実施例に示した効率を便宜のため第2 図にブロットした。第2図の点線は傾向を示す にすぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そとに示されたデータは 関係式

log(電力転換効率)=log(ELig子効率)+log K (上記式中Kは切片(intercept) であり、 駆動電圧によって一部制卸される係数である) に従うとほぼ直線状である。駆動電圧(第1図 の電源26)の値が上がるのに伴って、第2図 の曲線は下方へ移動する。従ってより高い駆動 電圧では、同一のEL電子効率でも、もはや希 望する9×10 W/W の電力転換効率を与えた いようになるであろう。

#### 4. [ 図面の簡単な説明]

第1 図は 関源に 接続した本 発明 装備の 一部の 概略的 新面図であり、

第2図は本発明接近に関する電力転換効率対 エレクトロルミネッセント電子効率を示す対数 - 対数グラフである。 図中の各記号は下記のものを表わす。

10:エレクトロルミネツセント 装置:

12:陽極; 14:ガラス製支持体;

16:半透明被膜;

18:正孔インジェクション層; 20:発光層;

22: 路框; 24:リードワイヤ;

26:遺源。

特許出願人 イーストマン・コダツク・カンパニー

代 哩 人 弁 哩 士 汤 浅 恭 三 憲則 (外4名)



